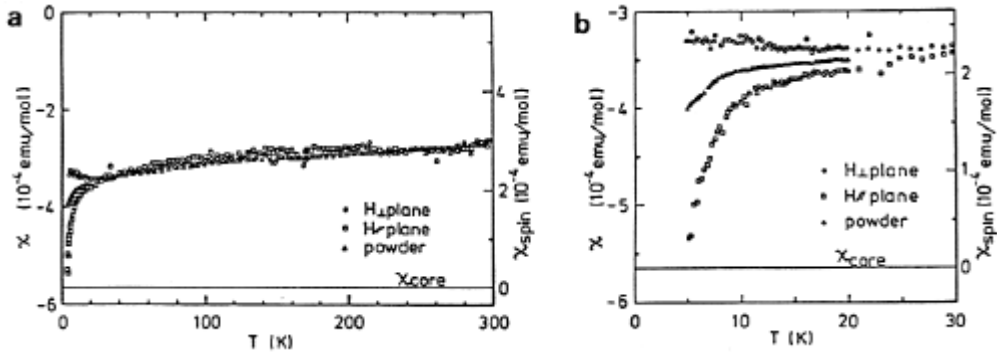


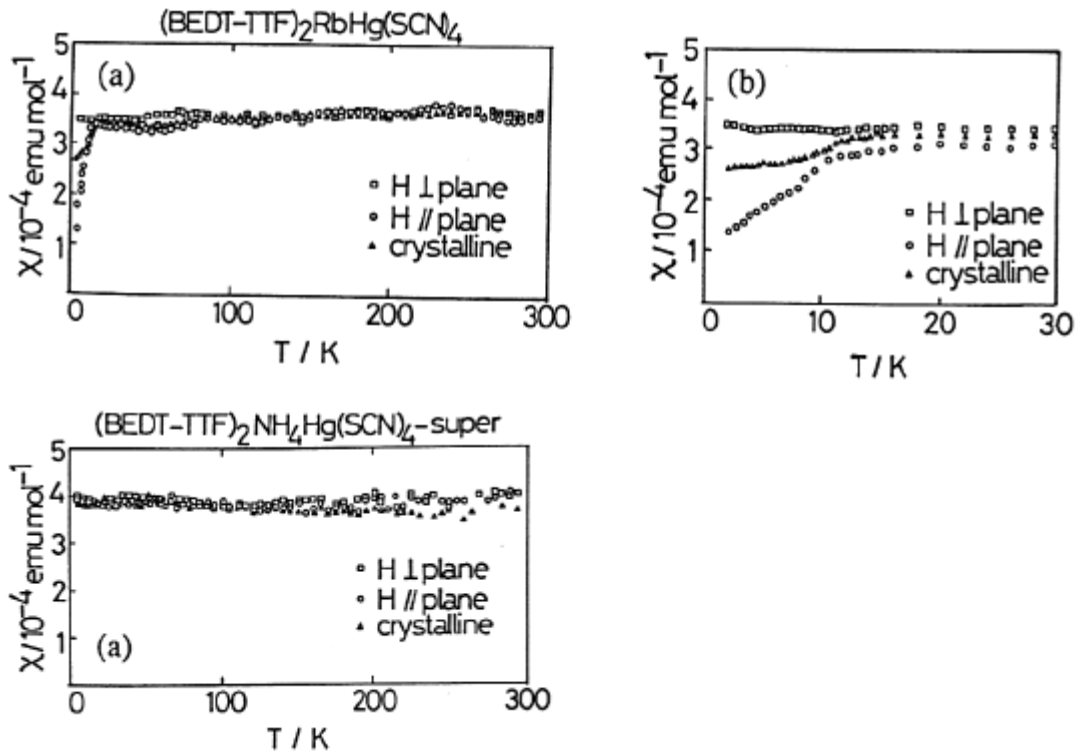
[4]  $\alpha$ -(ET)<sub>2</sub>MHg(SCN)<sub>4</sub> (M=K, Rb, NH<sub>4</sub>)

$\alpha$ -(ET)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>



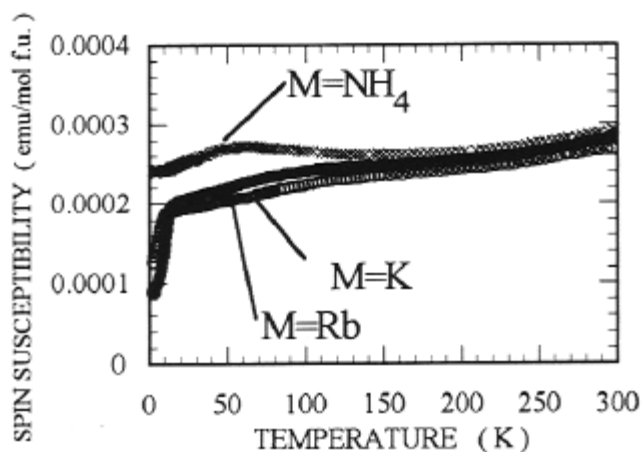
T. Sasaki, H. Sato and N. Toyota, Synth. Met.41-43, 2211 (1991).

コメント： 1)単結晶と粉末試料の静磁化率、2)磁場(H)の方向は2次元伝導層に対しての方向、3)コアの反磁性磁化率を  $-5.66 \times 10^{-4} \text{emu/mol}$  として補正、4)印加磁場は5テスラ。



H. Mori et al., Synth. Met.55-57, 2443 (1993).

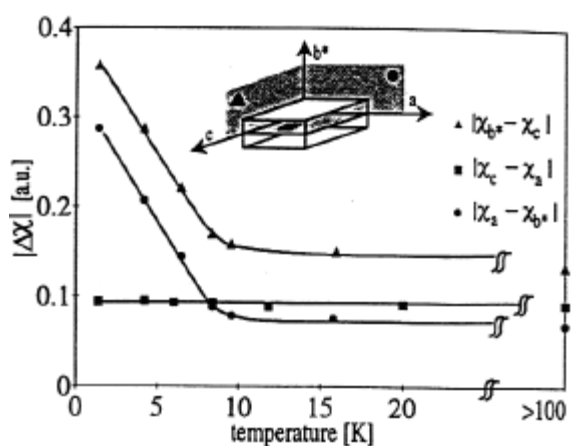
コメント： 1)配向試料と多結晶試料(図で crystalline と表記されている)の静磁化率、2)磁場(H)の方向は上に同じ、3)コアの反磁性磁化率は補正済み、4)印加磁場は5テスラ。



K. Miyagawa, A. Kawamoto, and K. Kanoda, *Synth. Met.* **86**, 1987 (1997).

コメント： 1)多結晶試料の静磁化率、2)コアの反磁性磁化率を補正済み、3)印加磁場は1 テスラ。

### M=K の磁化率の異方性



P. Christ et al., *Synth. Met.* **86**, 2057 (1997)

コメント： 1)磁化率テンソルの主軸 ( a, b\*, c; b\*は伝導面(ac 面)に垂直 ) の間の異方性、2)トルクによる測定、3)縦軸は任意単位